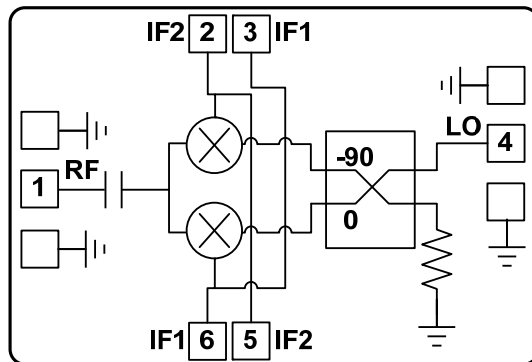




主要特点

无源式, 不需要直流偏置
射频频率: 15 - 23.6 GHz
变频损耗: 9 dB
镜像抑制: 20 dB
LO/RF 隔离: 45 dB
中频带宽: DC - 3.5GHz
输入 P1dB: +16dBm
芯片尺寸: 1.49× 1.14× 0.1 mm³

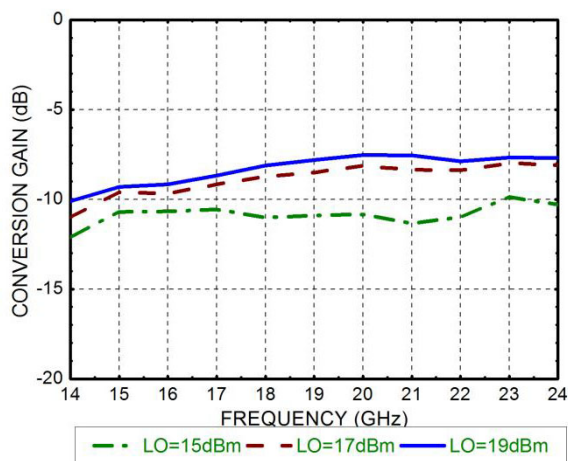
功能框图



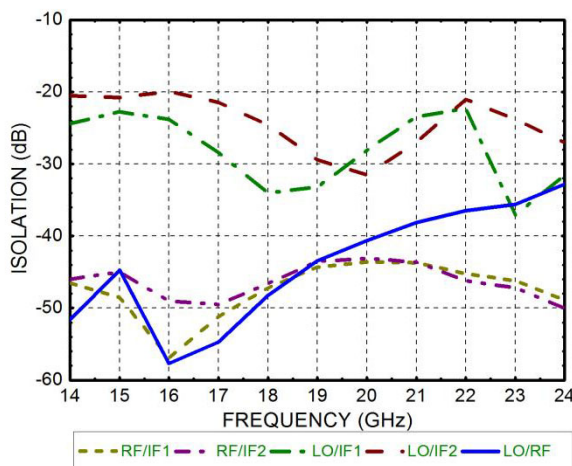
性能指标 ($T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $IF = 100\text{ MHz}$, $LO = +17\text{dBm}$)

参数	最小	典型	最大	单位
射频/本振频率 (RF/LO)	15 - 23.6			GHz
中频频率 (IF)	DC - 3.5			GHz
转换损耗		9		dB
镜像抑制		20		dB
隔离度 "LO 至 RF"		45		dB
隔离度 "LO 至 IF"		25		dB
隔离度 "RF 至 IF"		50		dB
输入功率 1dB 压缩点		16		dBm
输入 IP3		24		dBm

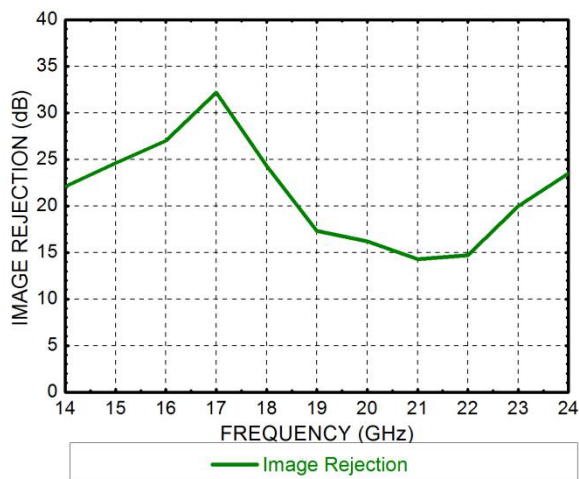
转换增益 vs. 本振驱动



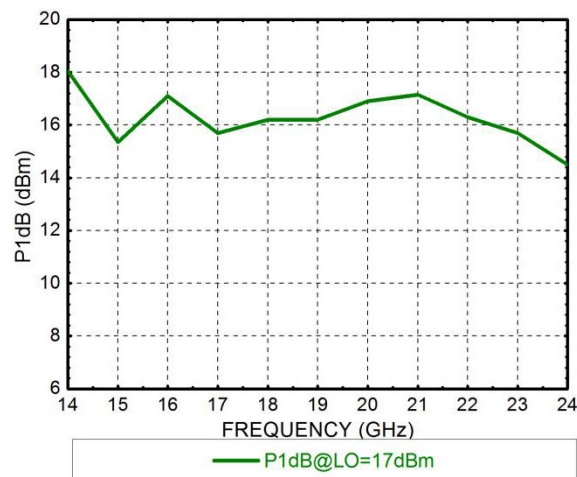
隔离度



镜像抑制

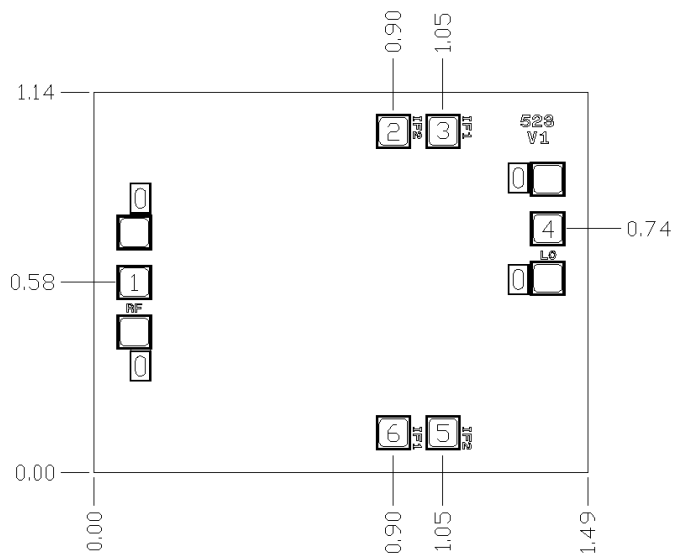


输入功率P1dB



物理参数

单位: 毫米



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF	该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
2,3,5,6	IF1, IF2	该焊盘是 DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
4	LO	该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

射频/中频输入功率: +21 dBm

储存温度: -65~+150°C

本振驱动功率: +27 dBm

工作温度: -55~+85°C

注意事项: 本产品采用空气桥工艺, 表面不带钝化层。